文章编号:1006-9941(2010)04-0427-04

铝-氧化铜复合薄膜化学反应性能

朱 朋,沈瑞琪,叶迎华,胡 艳,黄道伍 (南京理工大学化工学院, 江苏南京 210094)

aterials.org.cn すま化学F 摘 要:用磁控溅射的方法制备了铝-氧化铜复合薄膜,采用差热分析(DSC)方法研究了其化学反应性能。研究结果表明:铝-氧 化铜复合薄膜在一定的条件下,可以发生氧化还原反应,化学反应热为 $\Delta H = -1197.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$,与标准状态下的 ΔH^0 = -1203.8 kJ·mol⁻¹十分接近。用 Kissinger 方法计算了第二步反应的活化能为 565.146 kJ·mol⁻¹,说明在无外界刺激的情况下, 薄膜材料可以稳定存在。理论推导出,反应可以达到的最高温度是2573 ℃(即铜的沸点),薄膜间的化学反应分两步进行。

关键词: 军事化学与烟火技术; Al/CuO 复合薄膜; 热分析; 化学反应性能 中图分类号: TJ55; O69

文献标识码:A

DOI: 10.3969/j.issn.1006-9941.2010.04.016

引 1 言

铝-氧化铜复合薄膜是一种具有化学反应性能的 含能薄膜材料,由于化学反应的参与增强了薄膜的能 量释放强度,这种薄膜材料有可能用于电爆装置的换 能元,提高能量转换效率,实现桥箔的能量倍增。此 外,这种薄膜材料还可以用于微机电系统(MEMS)火 工品的发火单元和能量传递单元,实现含能装药的小 型化。因此,铝-氧化铜复合薄膜在提高电爆装置的可 靠性和小型化方面具有潜在的应用价值。2003年 Blobaum 等^[1]为实现微机械的焊接,开始研究了铝-氧 化铜多层薄膜的自蔓燃烧特性。2007年 ZHANG Kai-li 等^[2-3]用电镀铜后热退火的方法制作了氧化铜 纳米线,并用铂金作为加热桥,测试了其能量释放强。 度,取得了较好的效果,但成本太高,没有对反应性能 作出进一步分析。2004年沈瑞琪课题组开展了错-氧 化铜,镁-氧化铜,铝-氧化铜三种复合薄膜材料的制备 和性能研究,表明了铝-氧化铜具有更强的放热 量^[4-6]。本实验用磁控溅射的方法制备铝-氧化铜复 合薄膜,掌握了制备工艺和条件,并对材料进行结构表 征和热分析,计算了复合薄膜第二步反应的活化能,分 析了复合薄膜反应性能。

收稿日期: 2009-11-26; 修回日期: 2010-04-02 基金项目:国防科技重点实验室基金资助(9140C3701020901) 作者简介:朱朋(1978-),男,助理研究员,在职博士,主要从事火工技 术及薄膜材料研究。e-mail:zhupeng05@ hotmail.com

实验部分 2

2.1 磁控溅射

使用的铝靶和氧化铜陶瓷靶纯度均为99.99%, 基底材料为普通载玻片,经丙酮、乙醇和去离子水超声 清洗后烘干。磁控溅射的条件对成膜速率和质量影响 都很大,经过一系列实验,对不同条件下制作的铝膜和 氧化铜膜进行表征,得出制备铝薄膜较好工艺条件是: 溅射气压 0.4 Pa,溅射功率 150 W,氩气质量流量 30 mL · min⁻¹(standard state); 制备氧化铜薄膜较 好工艺条件是: 溅射气压 0.4 Pa, 溅射功率 200 W, 氩 气质量流量 30 mL · min⁻¹。在此条件下制备的薄 膜,经采用美国产的 XP-2 型台阶测试仪测量薄膜的厚 度,成膜速率最快,铝膜和氧化铜膜均可以达到 10 nm · min⁻¹。经扫描电子显微镜和原子力显微镜 表征后发现膜表面平整,颗粒大小均匀致密。经电子 能谱分析和 X 射线衍射分析后,发现膜表面的元素和 靶材相同,杂质元素比较少,铝膜和氧化铜膜晶粒大小 适中,都小于40 nm,为多晶态。

2.2 DSC 检测与反应活化能计算

铝与氧化铜完全反应的物质的量之比为2:3,铝 薄膜和氧化铜薄膜的密度按照体密度计算,所用设备溅 射铝薄膜和氧化铜薄膜沉积速率大约10 nm · min⁻¹, 可以算出铝薄膜和氧化铜薄膜发生完全反应总的厚度 比是1:2。这个值只能用作参考,因为铝薄膜和氧化 铜薄膜厚度均低于1 µm,反应机理与块体材料有所不 同。为了比较,遴选出薄膜的理想厚度比,制备了五种

朱朋, 沈瑞琪, 叶迎华, 胡艳, 黄道伍

不同厚度比的铝-氧化铜复合薄膜。为了更有效地分 析薄膜样品的固相界面反应过程,采用了三层铝薄膜 夹两层氧化铜薄膜的结构形式,增强了界面反应的信 号强度(图1)。制备成复合薄膜后,将其从基片上取 下,使其成为自支撑薄膜,消除基片的影响,可以最大 程度反映来自界面反应的信号。

采用 METTLERTOLEDO 功率补偿型 DSC 测定 铝-氧化铜复合薄膜的热效应,可以直接用 DSC 的峰 面积来计算试样的总焓变 ΔH 。为了用 Ozawa 方程和 Kissinger 方程计算反应的活化能,设定温度范围 25 ~ 1000 ℃,升温速率分别为 5, 10, 15, 20 ℃ · min⁻¹。 复合薄膜质量为 1.0 mg 左右,用陶瓷坩埚,氮气保护, 气体流量为 40 mL · min⁻¹。实验得到的 DSC 图形状 都很相似,图 2 是升温速率为 10 ℃ · min⁻¹的 DSC 图。



图1 复合薄膜结构图

Fig. 1 Schematic diagram of the multilayer films



图 2 Al/CuO 复合薄膜 DSC 曲线 Fig. 2 DSC curve of the Al/CuO multilayer films

3 结果与讨论

3.1 反应热与活化能

从图 2 可以看出,反应有两个放热峰,第一个放热 峰起始温度约 300 ℃,终止于 500 ℃左右,第二个放热 峰起始温度约 750 ℃,终止于 950 ℃左右。铝的熔点是 660 ℃,薄膜材料在远低于铝熔点时就发生了化学反应,比固体颗粒铝热剂降低了约 360 ℃,热感度明显提高。同时铝熔点明显低于第二个放热峰起始温度,所以在第二步反应之前,铝薄膜已经全部熔化。从 DSC 图中读取放热峰的面积,可以大致计算出反应热,在单层铝薄膜和单层氧化铜薄膜的厚度分别为 0.25, 0.6 μ m 时反应热最大, $\Delta H = -1197.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$,与标准状态下的 $\Delta H^0 = -1203.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 相比,相差不大。

DSC 图有两个放热峰,复合薄膜的反应应分两步进行,每一步对应不同的活化能。Blobaum^[1]计算第一步反应的活化能约为 2.91 eV(280.291 kJ·mol⁻¹)。本文用 Ozawa 方程解得第二步反应的活化能约为 554.238 kJ·mol⁻¹,用 Kissinger 方程解得第二步反应的活化能为 565.146 kJ·mol⁻¹。两种方法计算的活化能值比较接近,可以认为铝-氧化铜薄膜的第二步反应的活化能为 565.146 kJ·mol⁻¹。从活化能可以看出,在常温下 Al/CuO 复合薄膜常温下很难发生反应,可以在常温下长期保存。第一步反应活化能的值远小于第二步反应活化能,要使第二步反应进行下去,就必须有较高的外界能量来激发。

3.2 薄膜界面反应过程

Coffey 等^[7-9]研究了 Nb/Al 和 Ni/Si 两种纳米多 层薄膜界面反应过程,提出了纳米多层薄膜界面反应的 两阶段模型:首先金属间化合物在亚层界面位置形成反 应核心,沿着平行于界面方向侧向生长成为一个连续的 化合物层,然后化合物层沿着垂直于界面的方向长大。

铝-氧化铜复合薄膜经 DSC 检测,出现了两个较 强的放热峰,说明反应经历了两个不同的阶段,每个阶 段又对应着相应的活化能。根据实验结果,推测铝-氧 化铜复合薄膜界面反应过程是(图3):首先铝薄膜与 氧化铜薄膜在层界面位置形成反应核心目反应,沿着 平行于界面方向生长成为一个连续的化学反应区,对 应于第一放热峰。当界面反应完全后,铝薄膜熔化,熔 化后的铝元素具有比较强的扩散能力,能穿过界面反 应区与氧化铜薄膜反应,反应沿着垂直于界面的方向 进行直至反应完成,同时放出大量的热,对应于第二放 热峰。在界面区,铝薄膜与氧化铜薄膜已经充分接触, 并且部分铝与氧化铜已经相互扩散,因此反应不需要太 高的外界能量,所以反应温度较低,与之对应的第一步 反应活化能也较低。当界面区反应完全后,其生成物把 铝薄膜和氧化铜薄膜分开,因此必须有更高的能量使得 铝薄膜熔化后再穿过界面区与氧化铜薄膜反应,所以反 应温度较高,与之对应的第二步反应活化能也增高。



图 3 Al/CuO 复合薄膜反应两阶段示意图

Fig. 3 Schematic of two-stage model for redox in Al/CuO multilayer films

4 薄膜反应温度

火工品点火材料所能达到的温度至关重要,本研 究通过理论计算预测了铝-氧化铜复合薄膜材料,在发 生化学反应时所能达到的温度,并通过实验进行验证。

假设反应在绝热的条件下进行,反应后的产物是 固体,根据化学反应方程式:

 $CuO + \frac{2}{3}AI \rightarrow Cu + \frac{1}{3}AI_2O_3$

建立方程式:

 $-\Delta H_r = (x_1 c_1 + x_2 c_2) (T_0 - T_i)$ (1) 式中, ΔH_r 是生成 1 mol 铜和 1/3 mol 氧化铝的焓变, $\Delta H_r = -401 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, T_0 是反应的最高温度, T_i 是 反应的点火温度,因为复合薄膜用火柴即可点燃,所以 可以暂定 T_i 是 800℃, x_1 和 x_2 是生成的铜和氧化铝 的物质的量, $x_1 = 1 \text{ mol}$, $x_2 = 1/3 \text{ mol}$, c_1 和 c_2 是铜 和氧化铝的等压比热容, $c_1 = 24.4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \mathbb{C}^{-1}$, $c_2 = 79 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \mathbb{C}^{-1}$ 。

解得: T₀ = 8704 ℃

 T_0 的值远高于铜的熔点(1083 ℃)和氧化铝的熔 点(2050 ℃),因此铜和氧化铝肯定熔化,于是(1)式 可以改写成(2)式:

$$-\Delta H_{r} = (x_{1}c_{1} + x_{2}c_{2}) (T_{0} - T_{i}) + x_{1}\Delta H_{m1} + x_{2}\Delta H_{m2} + x_{2}\Delta H_{r2}$$

式中, ΔH_{m1} 是铜的熔化焓, $\Delta H_{m1} = 13.04 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, ΔH_{m2} 是氧化铝的熔化焓, $\Delta H_{m2} = 108.68 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 在 1050 ℃与 1220 ℃之间氧化铝会从 γ 相转化为 α 相, ΔH_{t2} 为氧化铝 γ 相转化为 α 相的相变焓, $\Delta H_{t2} = 21.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

解得: T₀ = 7589 ℃

该温度远高于铜和氧化铝的沸点,铜的沸点为

2573 ℃,小于氧化铝的沸点 2977 ℃,可能有部分铜 先蒸发。因此,计算铝和氧化铜反应温度时要考虑铜 蒸发热,铜的蒸发热 $\Delta H_{v1} = 303.47 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, T_0 =$ 2573 ℃(铜沸点),铜蒸发的物质量 $x_3 = (x_1 c_1 + x_2 c_2)(T_0 - T_0) +$

$$x_1 \Delta H_{m1} + x_2 \Delta H_{m2} + x_2 \Delta H_{12} + x_3 \Delta H_{v1}$$
(3)

$$\Re \mathcal{H}: x_3 = 0.838 \text{ mol}, x_3 < 1 \text{ mol}$$

edox in Al/CuO 因此点火后只有部分铜蒸发,薄膜反应的最高温度是2573 ℃(即铜的沸点)。铜蒸发的物质量是在绝热条件下得到的,考虑到实际点火过程中的热损失,蒸发的铜物质量应比计算值要小。 为了验证计算结里 ↔

为了验证计算结果,我们把薄膜从基片上剥离下 来,用火柴点燃使薄膜发生化学反应,发现有铜颜色的 液滴出现,特别在薄膜的边缘和反应的末端出现了大量 的铜颜色的液滴。但是在点火区没有铜的液滴,这是 因为在点火区,反应薄膜被火柴加热,预热增加了薄膜 点火区的反应热量,使得点火区的铜大部分蒸发,其他 地方反应的热量只能使生成的铜熔化不能使它蒸发。 实验结果与理论计算吻合较好,可以认为铝-氧化铜复 合薄膜发生化学反应的最高温度是 2573 ℃。图 4和 图 5 分别是点火前和点火后的铝-氧化铜复合薄膜。



图4 点火前 Al/CuO 复合薄膜

Fig. 4 Al/CuO multilayer films pre-ignition



图 5 点火后 Al/CuO 复合薄膜 Fig. 5 Al/CuO multilayer films after ignition

(2)

5 结 论

磁控溅射法制备铝-氧化铜复合薄膜,制作方法相 对简单,生产效率较高。通过热分析的方法,得到了铝 薄膜和氧化铜薄膜发生化学反应的理想厚度比,计算 出了薄膜第二步反应的活化能(565.146 kJ·mol⁻¹) 和薄膜反应的最高温度(2573 ℃),并在此基础上对 薄膜的反应性能进行了分析。可以确定,铝-氧化铜复 合薄膜材料是一种新型的火工品材料,这种薄膜材料 有可能用于电爆装置的换能元,提高能量转换效率,实 现桥箔的能量倍增。在今后的工作中,将着重研究铝-氧化铜复合薄膜材料在外界能量如电、激光等刺激下 的反应效果,以及与其他含能材料的实际作用效果。

参考文献:

- Blobauma K J, Wagner A J. Investigating the reaction path and growth kinetics in CuOx /Al thermite reaction in a multilayer foil geometry[J]. *Journal of Applied Physics*, 2003 (94): 2915 – 2922.
- [2] ZHANG Kai-li, Rossi C, Tenailleau C, et al. Development of a nano Al/CuO based energetic material on silicon substrate [J]. *Appl Phys Lett*, 2007(91): 113 – 117.
- [3] ZHANG Kai-li, Rossi C, Petrantoni Marine, et al. A nano initiator

realized by integrating Al/CuO-based nanoenergetic materials with a Au/Pt/Cr microheater[J]. *Journal of MEMS*, 2008(17): 832-836.

[4] 崔庆华. 氧化铜-锆复合膜的制备与性能表征研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2006.CUI Qing-hua. Study on the preparation and characterization of

Zr/CuO multilayer films [D], Nanjing Nanjing Institute of Technology, 2006.

[5] 朱朋. 微推进器点火桥阵列制作及性能研究[D]. 南京: 南京理 工大学, 2007.

ZHU Peng. Study on the preparation and performance of microthruster ignition array[D]. Nanjing: Nanjing: Nanjing Institute of Technology, 2007.

- [6] 董能发. 铝-氧化铜可反应性膜的制备与性能表征研究[D]. 南京:南京理工大学,2008.
 DONG Neng-hua. Study on the preparation and characterization of Al/CuO reactive multilayer films [D]. Nanjing: Nanjing:
- [7] Coffey K R, Clebenger L A, Barmak K, et al. Evidence for nucleation during thin-film reactions [J]. Applied Physics Letters, 1989, 55 (9): 852 – 854.

Nanjing Institute of Technology, 2008.

- [8] Lucadamo G, Barmak K, Carpenter D T, et al. Microstructure evolution during solid state reactions of Nb/Al multilayers [J]. Acta Materialia, 2001, 49 (14): 2813 – 2826.
- [9] Barmak K, Rickman J M, Michaelsen C. Evolution of grain structure in thin film reactions [J]. *Journal of Electron Materials*, 1997 (26): 1009-1020.

Chemical Reaction Property of Al/CuO Multilayer Films

ZHU Peng, SHEN Rui-qi, YE Ying-hua, HU Yan, HUANG Dao-wu

(School of Chemical Engineeering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

Abstract: Al/CuO multilayer films were deposited with magnetron sputtering process and analysed with differential scanning calorimetry (DSC). Results show that the reduction-oxidation may happen. The chemical reaction heat is about 1197.5 kJ \cdot mol⁻¹. The activation energy of the second reaction calculated by Kissinger equation is about 565.146 kJ \cdot mol⁻¹. Because of the high activation energy, Al/CuO multilayer films can be conserved for a long time. The process of the reaction between films is composed of two steps and the highest temperature of the reaction is 2573 °C.

 Key words: military chemistry and pyrotechnic technology; Al/CuO multilayer films; thermal-analysis; chemical reaction property

 CLC number: TJ55; O69
 Document code: A

 DOI: 10.3969/j.issn.1006-9941.2010.04.016